

中国集成电路设计业 2012 年会召开

12月6日至7日,“中国集成电路设计业 2012 年会暨重庆集成电路创新发展高峰论坛”在重庆召开。

本届年会由中国半导体行业协会、重庆市经济和信息化委员会、“核高基”国家科技重大专项总体专家组共同主办,为期两天。年会以“开拓创新,发挥优势,优化产业结构,打造电子信息产业高地”为主题,深入探讨集成电路产业,特别是集成电路设计业面临的机遇和挑战;探讨提升企业基础能力,增强产业整体能力的途径,以满足市场的需求和提高国际竞争力需要。来自多个地方主管部门、集成电路相关企业、行业协会、投资机构等近 1000 名代表参加了大会。

西安市科技局任晖副局长、陕西省半导体行业何晓宁秘书长一行参加了此次盛会,与世界各地、港、澳、台的同行以及相关行业协会、中介组织等关于中国集成电路设计企业在技术、市场、应用、投资等领域互换信息、探讨合作,共同见证了此次会议的盛况。作为西部经济发展的桥头堡,陕西近年来的集成电路产业进入快速发展期,此次会议将对全面了解西部集成电路,尤其是设计产业发展差距及合作起到重要作用。

2012 年是国家工业和信息化部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》的第一年,作为战略性新兴产业的核心和基础,集成电路产业进入了新的十年黄金发展期。2012 年 5 月,财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号),是我国集成电路产业,特别是集成电路设计产业发展新十年的助推力。在新的政策鼓舞下,此次盛会结合重庆的地域优势,统筹东西部产业资源,培育核心技术,促进产业整合,提升核心竞争力,将对实现产业规模化快速发展产生深远影响。

陕西半导体行业协会开展西部集成电路设计业调研

为进一步了解中、西部地区集成电路设计业最新状况,更好地把握行业发展趋势,为 12 月召开的 IC 设计年会产业报告积累素材,陕西省半导体行业协会接受中国半导体行业协会设计分会委托,于 11 月对西安、重庆、成都三地进行了为其 1 个月的集成电

路设计企业实地调研和走访。调研通过座谈和数据采集的方式，与当地的代表性企业、协会或基地等公共服务平台，围绕企业基本现状、技术水平、产业政策需求、建议及产业公共服务问题等进行了深入座谈。

结合此次调研的具体工作，协会随后撰写了《关于西部地区集成电路设计产业的调研报告》，详细的分析了西部地区 IC 设计企业的优势与不足。三地集中表现的主要特点是：1) 依靠高校院所资源，中小企业孵化工作成绩突出；2) 注重政策引导与扶持，服务平台效果显著；3) 企业自主创新能力突出，知识产权保护意识明显加强；4) 技术产品覆盖面广，呈现强大市场活力。存在的主要共性问题为产业链发展不均衡，上下游配套亟待完善；产品与市场脱节，企业快速成长受限；高端人才竞争激烈，中小企业人才流动率升高等。

通过此次调研，可以清楚地看到东西部地区发展差距，为协会工作提出了更大的挑战。随着诸多国际半导体企业向西部的转移，整个半导体产业的不断成长，协会工作将迎来非常大的机遇与挑战，同时随之而来的还有很多的问题和困难。如何抓住这一机遇，趁势而为，有所作为，将成为协会下一步工作的重中之重。

西安基地参加第十五届中国留学人员广州科技交流会

2012 年 12 月 19 日，第十五届中国留学人员广州科技交流会（简称留交会）在美丽的花城广州开幕，国家集成电路设计西安产业化基地参加了本届留交会。

本届留交会以“广聚海外英才、创新驱动发展”为主题，共汇聚 2500 名海外高层次人才、3000 多个海内外项目，并提供 1 万多个岗位进行招聘。据了解，参会海外人才主要来自美国、加拿大、英国、新加坡、澳大利亚等 29 个国家和地区，其中获得博士学位的占 54%，超过一半具有 5 年以上海外工作经历，约 10% 属于顶尖人才。

这次大会呈现出三大特点。一是供需两旺，海外人才回国创业意向强烈；二是论坛创新度高，亮点纷呈，堪称国际高层次人才思想盛宴；三是科技创新成果展示亮点频出。

西安基地参会人员积极与半导体领域的 10 多个海外人才进行沟通，介绍了与项目相关的产业状况、西安的环境和相关优惠政策，并欢迎海外人才到西安考察。

2012 西部电源技术创新论坛在西安举行

11月24日,2012西部电源技术创新论坛在西安皇后酒店举行。论坛与中国电源行业协会合办,Vishay专家和很多其他行业专家一道,对各种话题做了专题报告,共同探讨在新能源、军工、通信、工业电源和其他行业中电容器、电阻、电感器、MOSFET、功率模块和二极管的应用。Vishay高级工程师 Tony Wei 介绍了在新能源和工业应用中使用二极管和功率模块的情况;Vishay 区域市场经理 Steven Lv 介绍了如何在各种电源应用中使用电阻和电感器,重点是选择正确元件的重要性,以及 Vishay 的电阻和电感器的特性和应用。

此次技术论坛涉及了电源的主要技术问题,为西部电源的发展拓展了视野,同时在技术层面也提升了解决思路。

西安-香港 IT 服务业合作交流会在港举行

11月22日,2012•西安-香港 IT 服务业合作交流会在香港举行。交流合作会上,共有25个合同项目成功签约,项目总投资额77.39亿美元。

省委常委、常务副省长娄勤俭出席,市长董军致辞。中央人民政府驻香港联络办公室副主任郭莉,香港文汇报董事长、社长王树成,中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长许琳,香港陕西联谊会会长郑翔玲,华润(集团)有限公司副董事长王印,恒基兆业地产有限公司执行董事及中国业务主管叶盈枝等香港嘉宾出席会议。市委常委、高新区党工委书记、管委会主任赵红专参加会议,副市长韩松作西安投资环境与 IT 服务业发展情况推介,市政府秘书长王德安主持。

在此次合作交流会上,西安高新区与香港软件行业协会签订了框架战略合作协议,双方基于陕港在区域电子信息产业的市场、技术、管理等方面的互补性,将共同致力于推动西安与香港电子信息产业的进一步合作与发展。此外,25个合同项目在此次活动上成功签约,项目总投资额77.39亿美元,其中外商投资53.8亿美元,占项目总投资额的69.5%。据悉,签约项目主要集中在电子、商贸、物流、交通、旅游等服务性行业。

香港科技园公司、西安软件园发展中心、西安服务外包产业园管理中心相关负责人作交流发言,来自香港政商界的270余名嘉宾代表参加了此次活动。(来源:西安晚报)

IBM 中国系统与科技开发中心落户西安

11 月 29 日,世界 500 强 IBM 公司中国系统与科技开发中心落户西安。该中心将在技术运算领域进行研发,助力西部地区信息化发展。

据介绍,IBM 中国系统与科技开发中心承担着 IBM 全部系统硬件和系统软件平台的核心研发工作。此次成立的西安中心,是继 IBM 中国系统与科技开发中心落户上海、北京、台北和无锡之后的又一个位于中国本土的 IBM 全球研发机构。随着西安中心的成立,IBM 将把国际领先的研发资源引进西安,并将与西安本地高校进行进一步合作,带动我市创新型人才培养。IBM 还携手西安高新区,将共同建设 7 平方公里的软件新城,该项目将采用世界领先的技术和科技成果,以及 IBM 先进的解决方案。(来源:西安日报)

中国半导体照明/LED 产业与应用联盟第一届年会在渭南召开

12 月 4 日至 6 日,中国半导体照明/LED 产业与应用联盟第一届年会在渭南召开。工业和信息化部电子信息司、消费品工业司、陕西省工信厅、渭南市政府和渭南国家高新技术产业开发区等相关领导出席会议并讲话。本次年会由中国半导体照明/LED 产业与应用联盟主办,陕煤化西安重装渭南光电科技有限公司承办。中国半导体照明/LED 产业与应用联盟主席陈燕生出席年会并讲话,联盟秘书长关白玉主持会议。

陕西省委省政府将七个战略性新兴产业作为陕西省发展的重点,特别是对半导体照明/LED 产业从财政投入、政策支持、鼓励创新、推动应用等多方面给予支持,集聚陕西传统能源和科教等优势资源,助力半导体照明/LED 产业的发展。陕西省工信厅相关领导表示,将加强对半导体照明/LED 产业的部署,出台相关政策和措施,推进产业发展;并将积极寻求与国内外优势企业的合作,提升陕西省半导体照明/LED 产业在国内产业分工中的地位,在更大范围、更广领域、更高层次上参与国内国际半导体照明/LED 产业合作与竞争。(来源:半导体照明网)

多个电子信息项目围绕三星落户西安

11月25日,“西安-深圳电子信息产业合作交流会”在深圳举行,两家世界500强的三星配套企业与高新区签约。省委常委、常务副省长娄勤俭、西安市市长董军等政商人士出席交流会。

西安高新区签约12个电子信息项目,包括为三星电子西安芯片项目配套的两个投资达2.65亿美元的外资项目:美国空气化工投资1.45亿美元的三星大宗气体和压缩干燥空气项目、日本住友一期投资1.2亿美元的精细化学品精制工程。

据了解,除了昨日签约的两家企业外,现已有近50家三星的配套企业在高新区开工建设。在签约项目中,宇龙酷派将在高新区投资30亿元设立手机产业链公司。“公司食堂专门有陕西菜。”该公司董事长郭德英说,这个项目建成后,“陕西的人才就能在家门口工作、生活了。”

业内人士分析认为,这标志着在西安启动建设的韩国三星电子高端存储芯片项目所带来的综合效益正在逐步显现,这将使内陆省份陕西加快形成IT产业“高地”。

据悉,三星项目一期投资达产后形成的660亿元人民币的年产值,有望同时吸引160多家配套企业进驻,形成年产值1000亿元的产业集群,创造1万多个就业岗位。
(来源:新华网)

高新区召开三星项目总结表彰大会

12月19日,高新区召开三星项目总结表彰大会,表彰在三星项目招商、审批、建设以及征地拆迁过程中涌现出一批先进集体与先进个人。市委常委、高新区管委会主任赵红专出席。

三星项目自2011年二季度启动以来,在省委、省政府和市委、市政府的正确领导下,在高新区各级各部门的共同努力下,于2012年4月10日正式签约,9月12日破土动工。其间,承载三星项目的西安高新综合保税区,从6月份启动申报到9月份获批,仅用了88天,开创了国内综保区审批的全新速度;三星项目征地拆迁涉及面广、人数众多、任务紧迫,是关系到项目能否顺利建设的难点工作,高新区与长安区密切配合,仅用5个月时间就完成了项目涉及的7个行政村的征地拆迁任务,保障了项目顺利开工建设。

大会授予高新区电子信息重大项目促进办公室“三星项目招商引资先进集体”荣誉称号；授予杨仁华等 9 名同志“三星项目杰出贡献奖”。赵红专要求高新区广大党员干部要以更加勤勉务实的工作作风，确保三星项目早日建成投产；要继续以抓三星项目建设为核心，带动一批重大项目建设大提速大发展。（来源：西安日报）

求真务实 三星项目建设新进展

目前，三星主厂区基桩处理已全部完成，现场大规模工程建设已全面展开，主厂区基桩处理已全部完成，正式供水、供电、道路、供热、污水处理等正在抓紧建设。

其中，厂房主体施工单位已完成招标，并已进场施工，预计明年 5 月实现厂房主体封顶，11 月工程完工；“两纵一横一环”的路网管网建设进展顺利，草堂至综保区供水管网已完成开挖 4.2 公里；污水处理厂现已完成开挖 11 万立方，完成总量的 71%；110KV 变电站已完成基坑开挖，主要设备已完成招标；供热中心主厂房混凝土垫层、水泵房砂石回填完成。

同时，为确保三星项目的防洪安全，高新区还启动了洹河治理工程；为保证三星及周边企业运输高效快捷，确定在综保区北端，修建一条长 5.6 公里的快速干道，目前基础土方完成 94.2%；桥梁桥墩完成 84.2%；综保区的控制性详细规划已经确定，预计明年三季度建成，通过国家验收后正式封关运行。

三星项目的产业带动效应目前也已显现。其吸引的配套企业主要有投资设厂类、仓储及泵类、设备供应类 3 类。其中，投资设厂类目前已有 6 家企业，5 家已完成注册；仓储及泵类已有 11 家。

与此同时，高新区还将通过坚持与三星方面定期工作例会制度、营造相对独立封闭施工环境、加强现场治安管理等综合服务保障工作，确保三星项目能按计划如期竣工，并尽最大努力帮助群众解决就业问题，使群众在项目建设中受益。（来源：西安晚报）

2012 世界半导体业几大特点

CSIP(工信部软件与集成电路促进中心)在 2012 年 11 月的研究报告中指出:

●2012 年全球半导体销售额将达 3010 亿美元,较 2011 年微幅增加 0.4%。不过预期 2013 年及今后一段时间全球半导体市场景气状况将趋于好转。2013 年与 2014 年销售额可分别达 3220 亿与 3370 亿美元,成长率为 7.2%与 4.4%。主要增长动力源于智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体的需求持续保持强劲势头。

●目前整个半导体产业以及周围相关的产业都正在从 PC 转向移动通信和无线领域,正逐步过渡到移动互联网时代。2012 年 11 月高通市值约为 1060 亿美元,首次超过英特尔的 1050 亿美元。一家是 PC 时代的芯片巨擘,另一家是移动互联网时代的芯片新贵,资本市场的态度可能预示着,移动互联网占主导地位的时代已经正式到来。

●多屏 SOC 主芯片架构趋于融合,IC 产品的种类会减少,平台化产品越来越起主导作用。智能手机、平板电脑、智能电视等多屏应用加速融合,高性能、低功耗、低成本的规格需求趋同,以及以 ARM-Android 为基础的全球智能生态系统形成,导致各种屏智能产品的 SOC 主芯片关键技术与架构趋于融合。

●3G 智能手机是我国消费市场热点。TD-SCDMA 芯片出货在 2014 年将达到 1.2 亿颗,而 WCDMA 芯片出货在 2014 年预计达到近 2 亿颗,考虑到 WCDMA 在全球市场的容量巨大及用户的国际漫游需求,同时支持 TD-SCDMA 和 WCDMA 的多模终端芯片市场机会巨大。

●我国大陆彩电 1.2 亿台的年产量,需要从台资和外资芯片公司采购约 1.1 亿颗电视 SOC 主芯片,其中台湾的联发科(已并购晨星)是主要供应商,约占我国大陆电视芯片采购量的 90%。目前我国市场上使用的数字电视 SOC 主芯片大部分从台资和外资企业采购,为我国本土芯片企业研发“进口替代”产品提供了市场机会。

●据我们对抽样 IC 设计企业的调查显示,2012 年大部分 IC 设计企业销售额均取得增长,总体增长率约为 21%,其中有 7 家企业今年销售额实现了翻番。中国集成电路设计业在美国和中国台湾地区之后稳居第三位。

●我国 IC 设计企业的产品覆盖广泛的应用领域,在手机、平板电脑、多媒体播放机、电子书等消费类产品上,国产芯片具有很强的竞争力,制造工艺达到 40nm 甚至 28nm,手机 SoC 芯片、电源管理芯片等已经进入三星等国际大厂的供应链。

●调查显示,我国芯片主流量产工艺采用 0.18 微米和 0.13 微米,两者相加所占比例为调查样本企业的 52%。有 25%的公司采用 65 纳米及以下工艺。采用 40nm 高端工艺的企业继续增加,占 9%,比 2011 年的 7%提高了两个百分点,并且有企业开始采用目前最先进的 28nm 工艺。

●从产品的集成度来看,我国 IC 设计企业普遍具备了百万门规模以上的设计能力,设计能力超过 1000 万门以上的 IC 企业比例达到了 36%,与 2011 年相比上升了 3 个百分点。设计能力在 100—1000 万门规模的 IC 设计企业占到调查样本企业总数的 50%。

●IC 设计企业碰到的主要问题是要降低设计成本、缩短设计周期,以及在日益复杂的 SoC 芯片上实现软硬协同设计。

●今年调查结果显示,国内将近 75%的 IC 设计企业选择 SMIC 做代工,选择台积电的比例降到 50%,再次是华虹 NEC、GlobalFoundries 和三星等厂商,SMIC 仍是我国 IC 设计企业首选的 Foundry 合作伙伴,对本土 IC 设计业的发展发挥重要支撑作用。

●越来越多的国内设计企业开始涉足 SoC 设计,对 IP 核的需求在稳定增长。预计 2012 年国内 IP 核市场规模约为 10.7 亿元。

芯片

中国细分领域芯片需求分析

电子信息产业已进入乔布斯所说的“后 PC 时代”或移动互联网时代,以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端成为带动半导体市场增长的核心动力。本报告将重点分析我国手机、数字电视、白色家电和小家电等应用领域对芯片需求情况。

1、手机芯片市场需求

随着移动互联网快速发展,以智能手机为代表的移动智能终端发展迅猛。2012 年中国 3G 手机芯片市场容量预测:

TD-SCDMA 芯片在 2014 年将达到 1.2 亿颗,而 WCDMA 芯片出货在 2014 年预计达到近 2 亿颗,考虑到 WCDMA 在全球市场的容量巨大及用户的国际漫游需求,同时支持 TD-SCDMA 和 WCDMA 的多模终端芯片市场机会巨大。

2、国内电视(机顶盒)芯片市场需求

我国大陆彩电 1.2 亿台的年产量,需要从台资和外资芯片公司采购约 1.1 亿颗电视 SOC 主芯片,其中台湾的联发科是主要供应商,约占我国大陆电视芯片采购量的 90%。

我国本土芯片企业华亚微电子目前能提供此类芯片，但还处于小批量试用阶段，尚未实现大规模的产业化应用；海思半导体的数字电视多芯片智能电视方案已经对彩电大厂量产，单芯片 SOC 主芯片方案仍在研发过程中。目前我国市场上使用的数字电视 SOC 主芯片大部分从台资企业采购，为我国本土芯片企业研发‘进口替代’产品提供了市场机会。

在机顶盒芯片方面，根据 CSIP 对企业调研和业界评估测算，2012 年我国机顶盒 SOC 主芯片需求量约在 1.4 亿片，其中包括有线机顶盒 SOC 主芯片约 4000 万片；地面机顶盒 SOC 主芯片约 2000 万片；卫星机顶盒 SOC 主芯片约 6000 万片；IP 电视机顶盒 SOC 主芯片约 2000 万片。

3、电源管理芯片市场

据 IHSiSuppli 公司的电源管理市场追踪报告，今年全球电源管理半导体市场预计大幅萎缩 6%，主要归因于全球消费市场明显疲软。

2012 年电源管理芯片营业收入预计从去年的 318 亿美元降至 299 亿美元。相比之下，去年该产业在 2010 年 314 亿美元的基础上小幅增长 1.5%。明年该市场将恢复增长，预计上升 7.6%至 322 亿美元，略高于去年的水平。对于电源管理半导体产业来说，7.6%的增幅相当一般。继明年之后接下来的 3 年，市场将保持温和增长，2016 年营业收入预计将达到 387 亿美元。

今年市场下降，主要源于全球消费者支出整体放缓。尽管智能手机和平板电脑等产品很受欢迎，但整体消费市场保持低迷，有些领域的下降趋势尤其明显，比如笔记本和其他电脑平台。

亚洲能源项目减速也是导致今年电源管理领域整体下滑的因素之一。鼓励住宅与商业楼宇安装节能型冷却系统的政府激励政策到期，但 2012 年未推出任何新的激励措施。然而，目前的多数设备都需要改进电源管理 IC 功能，这将驱动电源管理半导体产业的发展。

在电源管理 IC 供应商方面，欧美有模拟产品的半导体大厂几乎都涉足了电源管理 IC 领域，中国企业产品功能较专，起点不高，还没形成很大的规模，但各有特色。电源管理 IC 产业是一个新兴的产业，近几年增长率最高的企业达到 70%，整体复合增长率达到 30%。电源 IC 厂家不像数字 IC 被欧美几家大厂所垄断，电源 IC 厂商比较多和分散，关键是找到自己的位置。

半导体照明及显示

LED 产业现状

当前,全球已初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局,以日本的日亚化工、丰田合成,美国的科瑞、普瑞和德国的欧司朗为专利核心的技术竞争格局,来自日、美、欧的几大国际厂商代表了当今 LED 的上游水平,对产业发展具有重大影响。

随着全球 LED 市场需求的进一步加大,未来我国 LED 产业发展面临巨大机遇,但同时也存在着前所未有的挑战。目前,LED 核心技术和专利基本被国外垄断。可以说,我国的 LED 产业是在“快乐”中“痛苦”地前行。

当前,全球已初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局,来自日、美、欧的几大国际厂商代表了当今 LED 的上游水平,对产业发展具有重大影响。这种影响不仅体现在产品和收入上,更重要的是对技术的垄断,50%以上的核心专利都掌握在这几大厂商手中。而我国的 LED 还处于较低端的水平,80%左右的产品集中在景观照明、交通信号灯等应用市场,通用照明市场还在推广之中。

随着国内 LED 市场的蓬勃发展,越来越多的国外企业把目光转向中国。近几年,我国受理 LED 领域的专利申请数量逐年显著增加。

截至 2011 年底,我国共有 LED 企业 3000 余家,其中年产值上亿元的只有 140 家。然而,在这 140 家企业中,没有一家企业的产品年销售额超过 10 亿元,超过 5 亿元的也只有少数几家。究其原因,一是行业缺乏权威的行业技术标准;二是企业的研发主要集中在下游的应用领域,在上、中游的研发投入相对较少。而国外大公司和我国台湾地区的一些企业已经垄断了大部分 LED 核心技术,大陆企业只能把目光转向技术含量较低的下游应用市场。

我国 LED 行业除了核心技术竞争力不强之外,产学研结合比较松散也是制约其发展的一个主要因素。

面对国际竞争对手的“虎视眈眈”,国内企业更应苦练“内功”。首要的是加大自主创新力度,重点研发能够被市场广泛接受和认可的新技术;其次是与国外公司展开合作。应该在消化、吸收国外先进技术的基础上,加强模仿创新,通过对竞争对手的核心专利进行改进,提高其技术效果;再次是申请改进型专利,这是规避专利侵权风险的一条有效途径。加强产学研合作,是促进我国 LED 产业快速发展的有效途径之一。(来源:人民日报)

中国光伏产业贸易战

中国与美国、欧盟的光伏贸易战正在升级。继当地时间 11 月 7 日美国决定对华光伏产品征收反倾销和反补贴关税之后,8 日欧盟宣布对自中国进口的光伏电池产品发起反补贴调查,而这将是欧盟委员会迄今为止接到的最大一起反补贴申诉。

业内人士认为,目前,中国光伏产业进入重新洗牌、优胜劣汰的阶段,应该从强化行业管理、完善技术标准入手,大力推动行业整合。

美国国际贸易委员会当地时间 11 月 7 日作出终裁,认定从中国进口的晶体硅光伏电池及元件实质性损害了美国相关产业。美国将对中国产品晶体硅光伏电池及组件征收 18.32%至 249.96%的反倾销税,以及 14.78%至 15.97%的反补贴税。本次终裁结果标志着美国对华太阳能补贴贸易调查案的终结,美国商务部将向从中国进口的相关产品征收“双反”关税。

但根据美国国际贸易委员会的另一个裁决,针对此类产品的“双反”关税令不适用追溯原则,因此反补贴关税从今年 3 月 20 日起征收,反倾销关税从今年 5 月 17 日起征收。

11 月 8 日,英利绿色能源控股有限公司发布公告称,美国国际贸易委员会的终裁结果包括两个方面:首先,中国太阳能电池和组件的进口对美国的光伏产业造成“实质性的损害”;其次,本案不存在“紧急情况”。因此根据“紧急情况”的否定性裁决,英利绿色能源将无需支付此前计提的 1370 万美元“双反”费用。此外,采用第三国制造的电池、在中国境内完成封装的组件将不会被征收反补贴税和反倾销税。(来源:慧聪网)

三部委领导联袂出席 ChinaSSL2012 共论产业发展大事

11 月 7 日下午,第九届中国国际半导体照明论坛迎来了对中国半导体照明产业发展影响最为重要,中国半导体照明产业面貌的三位重量级嘉宾:国家发改委环资司副司长谢极,国家科技部政策法规司巡视员、技术创新工程领导小组办公室副主任、中国科技政策研究会副理事长李新男,工信部信息化推进司副司长秦海。三位司长的同台亮相,引起了业内外、国内外的广泛关注,他们对中国半导体照明产业高屋建瓴的发展意见,以及他们作为 LED 专家的个人观点,对我国半导体照明产业的发展思路和部署将有一个清晰的目标。

国家发改委环资司副司长谢极表示,战略性新兴产业的培育发展,一方面要制定一些相关的法律、法规、标准规范加强引导,另一方面就是要通过行业组织协调和加强行业自律。目前政府已经颁发修订了《节约能源法》,今年下半年发改委会同国家质检总局启动了“百项能效标准”,推动标准的制定。此外,在联盟的协助下发改委已经编制了《“十二五”半导体照明节能产业规划》,近期已经进入审批程序,有望在年底之前发布。“我们希望产业发展走大而强的途径,一些好的企业通过竞争和招标产生之后国家会支持其进一步做大做强,我们希望产业能有序的发展。”

国家科技部政策法规司巡视员、技术创新工程领导小组办公室副主任、中国科技政策研究会副理事长李新男司长表示,中国有可能与国际同步来发展这个新兴产业,并参与国际半导体照明产业链的构建。但目前我们在资本的投入和人才的积累方面还有很大的差距。产业下一步发展的策略就是按照协同创新的观点来积极构建产业链,并与国际接轨,同时要构成支撑产业链的技术创新链。科技部在半导体照明领域一直在按照产业链来部署技术创新链,在资金方面进行了持续投入,同时和发改委、工信部、财政部等部门联合开展了相应的示范工程推广 LED 产品的应用,在公共服务平台支撑企业发展环境方面也进行了布局。半导体照明产业联合创新已经形成了三种组织模式,第一种是国家半导体照明工程研发及产业联盟,第二种是在上述联盟基础上形成的半导体照明产业创新联盟,第三种组织模式就是在前两个联盟的基础之上,去年筹建成立的半导体照明联合创新国家重点实验室,发挥好这三种组织模式的作用,建立、鼓励协同创新的社会机制,使协同创新能够成为一种主导模式,这个产业就会做强作大。

工信部信息化推进司副司长秦海表示,半导体照明节能产业响应了全球范围绿色低碳和可持续的发展理念,它的最上游会连接着对自然资源的识别和利用,下游应用

会影响到智慧建筑、智慧城市的建设，关系到一个巨大的产业和生态体系。半导体照明发展理念的第一条就是智慧的光。智慧的光让我们对环境资源给予充分的尊重，也让人人的生活更有质量。半导体照明的进步将可能使微电子和光电子携手并进的时代到来。（来源：中国半导体照明网）

第十四届高交会开幕

11月16日，以“推进科技创新，提升发展质量”为主题的第十四届高交会在深圳会展中心隆重开幕。

第十四届高交会暨举行重点项目签约仪式，发布了一批科技含量高、发展前景广阔、产业化潜力巨大的优质项目。

本次签约仪式上共有16个项目的合作方签署协议，项目领域涉及新能源、新材料、云计算、集成电路、北斗卫星导航、物联网、创新服务业、节能环保、新一代信息技术等。项目建设单位包括各领域顶级科研机构，军工院所，掌握领先技术、拥有一流研发人才和设备的企业，国内外知名高校。该批签约项目其中很大一部分已经或即将入驻厦门产业技术研究院创新大厦。

2012年中国集成电路产业促进大会在广州召开

11月22日，为期2天的2012年中国集成电路产业促进大会暨第七届“中国芯”颁奖典礼于在广州番禺举办。

本届会议以“推动整机与芯片联动，打造集成电路大产业链”为主题，行业主管领导、专家学者及600多名集成电路产业链上下游企业代表等围绕会议主题，就整机应用带动芯片、以芯片研发支撑整机技术升级、增强国产芯片市场竞争力等方面进行深入探讨。

工业和信息化部软件与集成电路促进中心在大会上发布了《2012中国集成电路设计业发展报告》、《2011年芯闻参考汇编》等产业研究报告。报告称，今年我国集成电路设计业全行业销售额预计比去年同期增长20%以上，发挥了对整个产业的牵引和带动作用。

为了促进产业链上下游的沟通交流，大会还举办了“中国芯”产品及应用展。同时，“中国芯”品牌授权仪式也是此次大会的亮点，通过授权，东莞泰斗微电子将在其产品的封装和宣传材料上使用“中国芯”标识。此外，大会还举办了承办城市交接仪式，下一届大会将在南京召开。

2013 年移动芯片销售将首超 PC 芯片

市场研究公司 ICInsights 近日发布最新研究报告指出, 明年移动芯片销售额将首次超过 PC 芯片。台式电脑不断下滑的销售使得移动芯片销售在芯片销售市场上占据了主导地位。

ICInsights 在报告中预计, 明年包括智能手机芯片在内的移动芯片销售额将首次超过 PC 芯片。过去 20 年, PC 芯片销售额占到了整个芯片市场销售额近三分之一的比例。预计, 今年 PC 芯片销售额的占比将下滑至四分之一, 到 2016 年将不足五分之一。与此同时, 移动芯片销售额却一路飙升, 预计今年移动芯片销售额占整个芯片市场销售额的比例将达到 24%, 2016 年将增加至 32%。

发达国家智能手机销售强劲, 业界普遍预计未来几年新兴市场的智能手机销售也会出现大幅增长。

报告预计, 一直到 2016 年整个 PC 芯片销售仍将呈现增长的态势。到 2016 年, 台式电脑芯片销售年复合增长率为 0.1%, 笔记本电脑芯片销售年复合增长率为 7.4%。到 2016 年, 平板电脑芯片销售将会出现大幅增长, 年复合增长率将达 33.9%。

中国龙芯将成为英特尔同级竞争对手

中国自主研发的微型处理器将很快推向市场, 并将成为英特尔和 ARM 架构的同级别竞争对手。

目前, 整个计算机和移动市场处理器主要产品都由英特尔和 ARM 架构产品构成。一家来自中国的 BLXIC 科技公司, 同时作为中国科学院和合作伙伴, 将推出自己的芯片产品, 成为整个市场的第三股力量。明年初, 他们将推出适用于普通电脑、商用服务器甚至是超级计算机的芯片。

BLXIC 科技设计公司的最新产品型号被命名为 Godson-3B1500, 这款芯片的晶体管数量是上一代的两倍, 效率也提高了至少 35%。Godson-3B1500 是 32 纳米级芯片, 仍然落后于英特尔最新的 2 纳米大小, 该款芯片不支持微软的 Windows 系统, 虽将失去很大一部分市场。但产品造价十分低廉, 有助于促进发展中国家的互联市场发展, 尤其是那些被禁止设立服务器和云技术基础设施建设的国家。(来源: 中国集成电路)

我国芯片设计、制作工艺需加倍努力寻求突破

2012 年初, 富士通半导体宣布交付其为中小型 IC 设计公司量身定制的 55nm 创新工艺制程(可兼容 65nm IP、性能堪比 40nm 工艺), 一度引发中国 IC 设计业的震动。而

在日前于重庆举办的“中国集成电路设计业 2012 年会暨重庆集成电路跨越发展高峰论坛”上，富士通半导体率先将已经量产的成熟 28nm 先进工艺和设计服务带给中国高端 SoC 设计业者。

如果说高性价比的 55nm 创新工艺制程是为了一解处于激烈竞争中的本土中小客户 IC 设计之“渴”，那么此次富士通半导体带来的成熟已经量产的 28nm 半导体制造技术则是为帮助中国 IC 设计业应对高端先进制程 SoC 设计挑战而生。

但不可否认的是，在工艺制程上虽然国内引入了富士通的 28nm 制造工艺，但和世界其它一流厂商的最高制造工艺还是有差别。其中英特尔公司明年则会采用 22 纳米工艺。到 2014 年，英特尔计划将芯片工艺降至 14 纳米(理论最低值为 10 纳米)级别，通过这种措施，便可在相同体积内实现更高的性能。

ST 法国 Crolles 晶圆厂将投产 28 纳米 FD-SOI 制程技术

日前，意法半导体宣布其在 28 纳米 FD-SOI 技术平台的研发上又迈出一大步，其位于法国 Crolles 的 12 寸（300mm）晶圆厂投产该制程技术，这证明了意法半导体以 28 纳米技术节点提供平面全耗尽技术的能力。

FD-SOI 技术平台较传统制造技术，FD-SOI 技术可在大幅提升性能的同时大幅降低功耗，因此 ST-Ericsson 选择采用意法半导体的 FD-SOI 技术设计未来的移动平台。

意法半导体执行副总裁、数字产品部总经理兼首席技术与制造官 Jean-Marc Chery 表示：“在产品和技术研发领域，FD-SOI 技术的投产，使意法半导体再次跻身全球最具创新力的半导体技术研发制造企业之列，让我们能够在 28 纳米技术节点创建高成本效益的工业解决方案。”

中兴通讯率先完成中国移动 TD-LTE MR 可用性测试

近日，中兴通讯宣布与中国移动的 TD-LTE MR 测试取得重要进展，双方合作率先完成了 TD-LTE MR 一阶段测试，验证了 MR 在 TD-LTE 网络的可用性。后续双方将继续开展 MR 功能测试以及全面测试。可用性测试的完成为 MR 在 TD-LTE 网络中的应用打下了坚实的理论和实践基础。

在 2012 年 8 月完成的中国移动 13 个城市 TD-LTE 招标项目中，中兴通讯承担了北京、天津、广州、深圳和沈阳五大城市的 TD-LTE 试验网络建设任务，总载频数超过 13000。其中广州将建设 3700 个基站，占整个规模的 18.5%，建成后规模最大和场景最复杂的 TD-LTE 网络，其经验将对后续 TD-LTE 网络发展起到良好的借鉴作用。

目前，在中国移动已经投资建设的 LTE 项目中，中兴通讯成为中国移动第一大 LTE 设备供应商。（来源：中国集成电路）

中国移动选择赛肯通信为 TD-LTE 商用试验网络

近日,中国移动宣布与赛肯通信的两家设备制造商合作伙伴——国民技术(Nationz)和中启创(Primemobi)签订了部分合同。

赛肯通信技术在中国移动网络扩展的几大设备中运行应用,包括国民技术和中启创生产的无线 USB 软件保护器(加密狗)、移动路由器和客户终端设备(CPE)。国民技术携手赛肯通信历经数月,共同开发出双模 TD-LTE / TD-SCDMA 设备。中启创是云计算服务的领先供应商和高级端对端系统集成商。

国民技术副总裁张斌表示:“使用赛肯通信卓越的 LTE 芯片技术对我们为中国移动网络扩容开发先进而强大的 TD-LTE 用户设备具有很大帮助。”

中启创首席运营官王涛表示:“赛肯通信提供了稳健成熟的 TD-LTE 解决方案,我们非常高兴能够整合入赛肯通信的高质量设备。”(来源:中国集成电路)

电力物联网示范应用效果显著

近日,辽宁省电力有限公司科技信通部信息处编制的物联网示范应用项目可行性研究报告顺利通过审核。根据预计,电力物联网示范应用项目除了可以达到预期建设成果,经济效益也将十分显著,可优化备品备件资源利用率 10%至 20%,长远节省各类管理费用 20%至 30%,加快核心技术专利和自主知识产权获取,每年节约技改资本性投入 10%左右。

作为公司电力物联网建设的试点单位之一,电力物联网总体架构以 SG-ERP 总体架构为基础,主要包括感知层、网络层和应用层 3 个层次。其中,感知层实现各个环节数据的统一感知与表达;网络层将不同的通信技术屏蔽,按照规范化的统一通信规约实现对数据的传送;应用层完全遵循 SG-ERP 的体系架构,基于统一应用平台,支撑各类业务应用。

电力物联网示范应用项目的预期建设成果,包含两个部分,一是基于电力物联网总体架构形成的统一信息模型及统一通信规约,在实际验证与修订完善后可最终形成电力物联网相关标准规范;二是电力物联网技术典型应用场景,可以提供业务辅助应用。”(来源:国脉物联网)

半导体产业联盟 CSA 发布两项 OLED 照明联盟标准

12 月 15 日,为实现技术标准研制与科技创新和产业发展紧密结合,中国半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)标准化委员会组织制定了 CSA 联盟技术标准,希望以科技进步和技术创新不断提高技术标准水准,以技术标准的研制与应用促进科技成果的转化应用,发挥技术标准的基础保障和支撑引领作用。

CSA 联盟标准由国家半导体照明工程研发及产业联盟标准化委员会(CSAS)制定

发布，版权归 CSA 所有，未经 CSA 许可不得随意复制；其他机构采用本标准的技术内容制定标准需经 CSA 允许；任何单位或个人引用本标准的内容需指明本标准的标准号。

CSA 提出并组织几单位起草制定了 CSA 014-2012《有机发光二极管照明 术语和文字符号》、CSA 015-2012《有机发光二极管照明测试方法》两项联盟标准。（来源：LED 在线）

份额增加 中国 LED 照明有望爆发性增长

根据今年 8 月科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，到 2015 年，我国半导体照明产业的规模将达到 5000 亿元，LED 照明产品的成本将降低至 2011 年的 1/5，在通用照明市场的份额要达到 30%。

“这意味着，在通用照明领域，未来三年 LED 照明市场有着约 10 倍的成长空间。”深圳市绿色半导体照明有限公司总经理陈宝东说。

地方政府对 LED 照明产业的支持力度不断加大。深圳市近日推出《深圳市推广应用 LED 照明产品实施方案》，明确提出用两年时间完成公共场所普及 LED 照明的目标。

虽然我国半导体照明应用企业数量很多，一些企业在关键技术上也有所突破，并在标准的制定方面取得良好进展，但是这些企业的规模较小，真正意义上的行业品牌仍严重缺失，我国的 LED 照明企业应该着力开发研究新的技术和专利，不单纯地增加产量，要提升 LED 产品的质量来增强产品和企业的竞争力，在 LED 照明产品高速增长的时期把握机会来推动 LED 的发展和 LED 照明的普及。（来源：新浪地产）

中央财政今年投 130 亿元支持光伏发电

12 月 16 日电记者近日从财政部获悉，根据国务院有关决定精神，为促进光伏行业健康发展，中央财政日前拨付 70 亿元资金，支持启动光伏发电应用示范 3157 兆瓦。

财政部数据显示，加上年初拨付 60 亿元启动的 1930 兆瓦，2012 年中央财政共拨付资金 130 亿元，支持启动光伏发电国内应用的总规模达到 5200 兆瓦，极大地推动了国内光伏发电应用示范。

据介绍，此次启动的金太阳示范工程 1 万千瓦以上项目有 146 个，装机规模 252 万千瓦，占总规模的 92%；江苏、山东、湖南、浙江、河南、广东、上海等光伏产业基础好的地区项目规模达到 160 万千瓦，占总规模近 60%；分布在龙头组件生产企业和大型投资开发企业的规模达到 150 万千瓦，占总规模的 55%，其中，前 10 家项目业主单位的规模达到 98 万千瓦，占总规模的 1/3。

此外，财政部在补助资金拨付上也做了进一步调整与完善，即按公告项目的规模、拨付标准及预拨比例，将财政资金拨付地方，由地方根据项目建设进度等情况将资金拨付至具体项目单位，更好地调动了地方管好用好财政资金的积极性，提高了财政资金使用效能。(来源:西藏日报)

光伏电站迎来微逆市场的爆炸式增长

国家电网公司 26 日正式发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》，国家电网覆盖的省份也纷纷推出并网细则。微型逆变器因其多发电量、设计寿命长、安装维护简单方便等优势，受到光伏组件厂、EPC 厂商的青睐。

在 APS 国内销售总部-上海办公室内，客户咨询微型逆变器产品的电话络绎不绝，由于最新的分布式发电政策的发布，上海电力已经开始受理分布式光伏发电并网。昱能光伏的销售经理帮客户算了一笔账，按 1 天发 3 度电计算，光伏系统在使用寿命的 20 年内，系统保守估计可以发发 21900 度电。目前根据国家相关政策，实行统购统销，电力公司按 1 元/度电收购，共计有 21900 元人民币收入，而在建立该 1.5kW 系统时的一次性投入成本为 9000 元。客户的预计收益可以达到 12900 元。

在光伏行业的艰难岁月里，组件厂、EPC 商将如凤凰涅槃，也许微型逆变器会给该行业带来重生的机会。(来源:世纪新能源网)

中国光伏企业依然有进入欧盟市场的机会

欧盟对中国光伏企业的“双反”调查正在进行中，目前已经进展到了一个什么样的阶段？光伏“双反”之后，中国的光伏企业是否还有进入到欧盟市场中的机会？12 月 11 日，中国经济时报记者专访了欧洲光伏产业协会秘书长 Reinhold Buttgerit。

对于欧盟的光伏“双反”之后，中国光伏企业是否进入到欧盟市场的机会的问题，Reinhold Buttgerit 回答：“中国的光伏市场在未来一两年当中将会成为全球最大的市场。在光伏‘双反’之后，中国的企业如果在欧盟市场寻求机会，还是有机遇的，这个机遇主要在于如何和非中国企业在欧洲竞争。但是在目前这个阶段，中国的光伏企业在欧洲发展并不会是非常容易的事情。”(来源:中国经济时报)

世界首个 28nm 多核通信处理器问世

近日，博通（Broadcom）公司宣布，推出低功耗 28nm XLP 200 多核通信处理器系列，这款新的优化解决方案可以满足企业、4G/LTE 运营商、数据中心、云计算和软件定义网络（SDN）对性能、可扩展性和效率等方面的需求。XLP 200 系列目前正在试样，量产时间定于 2013 年下半年，有多种型号和配置可供选择。

据介绍，博通公司的 XLP 200 系列是世界首个 28nm 多核通信处理器系列，可为数据平台、控制平台和异构应用提供最佳性能的 XLP 200 系列是业界唯一在单个芯片上结合了四发射、四线程和 2GHz 乱序执行功能，并具有网络集成和安全加速功能的通信处理器系列。

与此同时，为了应对网络和云中呈指数增长的恶意软件和入侵威胁，XLP 200 系列配置了业界最完整的高性能安全功能套件，让网络管理人员能够以线速对网络流量进行彻底地检查、加密和认证，以确保数据流的安全。

我国科学家研制出太赫兹肖特基二极管及电路

近日，中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室太赫兹器件研究组研制出截止频率达到 3.37THz 的太赫兹肖特基二极管和应用于太赫兹频段的石英电路。该器件作为太赫兹倍频器核心元件，经中电集团 41 所验证，性能与国际同类产品相当。

据了解，太赫兹波指的是频率在 0.1THz 至 10.0THz 范围的电磁波，被美国评为“改变未来世界的十大技术”之一。它在安全检查、无损探测、天体物理、生物以及军事科学等诸多科学领域有着重要的应用。具有极高截止频率的肖特基二极管能够在室温下实现太赫兹波的混频、探测和倍频，是太赫兹核心技术之一。（来源：中国科学报）

英特尔推首款 60 核芯片：霍金成首位用户

英特尔发布了首款 60 核芯片，但初期只有剑桥大学等著名机构才能使用。这款芯片名为至强 Phi，但与常规的英特尔处理器不同，它不太像是 CPU，反倒更像是与 CPU 配合使用的 GPU。

预计这种芯片将于明年发布，至强 Phi 协处理器 3100 家族将提供超过 1000gigaflop(1teraflop)双精度浮点性能。相比而言，英特尔的消费级处理器远未达到这种水平。

英特尔表示，剑桥大学的史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)教授和 Cosmos 实验室已经提前使用这一技术，将其应用于他们的 SGI 超级计算机。

“借助我们的 SGI UV2000 的性能和灵活性，我们可以继续专注于探索，并领导全

世界加强对宇宙的理解。”霍金在声明中说。

在美国本土，德克萨斯高等计算中心等英特尔客户也将获得早期定制版本。这款协处理器的首款商用版 Phi5110p 有望于 2013 年 1 月 28 日上市，建议零售价为 2649 美元。低端至强 Phi3100 产品则会于 2013 年上半年上市，建议零售价低于 2000 美元。

英飞凌交付第 1 亿颗 TriCore 单片机

日前，英飞凌科技股份有限公司刚刚交付了第 1 亿颗 TriCore™单片机。这使得 TriCore 单片机成为汽车电子领域最为成功的单片机之一，被五十多个汽车品牌选用。从统计角度而言，这意味着几乎每两辆车中就有一辆采用 TriCore 单片机。该单片机负责尽可能降低油耗和尾气排放。

TriCore 单片机被用在内燃机和变速箱中央控制单元中，用于控制燃油喷射、点火或废气再循环。它们现在还越来越多地用于混合动力汽车和电动汽车中。其他应用领域包括电动助力转向、刹车和底盘控制以及车身控制。TriCore 还用在与汽车不相关的领域，比如系统控制装置、太阳能逆变器和转向电机。

TriCore 由英飞凌开发，是英飞凌 32 位单片机的中央处理单元（CPU），可以说是单片机的大脑，正如计算机的 CPU 一般。

除了引擎管理和变速箱控制系统，英飞凌芯片还用在安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统（ESP）、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节和无钥匙进入系统等应用中。

Vishay 推出集成接近传感器

日前，Vishay Intertechnology, Inc.宣布，推出把红外发射器、光电二极管、信号处理 IC 和 16 位 ADC 集成进小尺寸 4.85mm x 2.35mm x 0.83mm 表面贴装封装的全集成接近传感器---VCNL3020，扩充其光电子产品组合。节省空间的 VCNL3020 支持易用的 I2C 总线通信，具有中断函数，集成的发射器驱动可扩大传感器的检测距离。

VCNL3020 的 16 位有效分辨率使器件在进行接近探测时能够很好抵御串扰，不需要在发射器和探测器之间加一个机械光栅。同时，VCNL3020 对发射信号进行调制，具有优异的抵御环境光能力。

该器件的中断函数使传感器能够独立工作，直到发生可编程的阈值事件，然后唤醒微控制器。

对于智能手机、触屏手机、PDA、GPS 单元和数码相机等移动设备，VCNL3020 可用作触摸屏锁定的接近传感器，达到节约功耗的目的。器件也可用作计算、工业设备和显示屏的光学开关。（来源：中国集成电路）

ADI 推出业界最小的隔离式 DC-DC 转换器

Analog Devices, Inc.最近推出业界最小的隔离式 DC-DC 转换器 ADuM5010、ADuM6010、ADuM521x 和 ADuM621x。ADuM5010、ADuM6010、ADuM521x 和 ADuM621x 采用 ADI 公司的专有 isoPower®隔离式 DC-DC 转换器技术,提供 150 mW 的输出功率,同时占用的电路板空间也小于基于模块的竞争产品解决方案。ADuM521x 和 ADuM621x 还集成了 ADI 公司屡获殊荣的双通道 iCoupler®数字隔离技术,与基于光耦合器的替代产品相比,占用的电路板空间减少高达 75%。

ADI 公司 iCoupler 数字隔离器产品线经理 David Krakauer 表示:“新的 isoPower 系列 DC-DC 转换器同时兼顾功率和尺寸因素,让客户能够在更小外形尺寸内设计更多功能和提高效率,同时最大程度降低系统成本。ADI 公司的协作方式、设计支持和系统级知识能够帮助我们的客户充分利用电源隔离技术。”

高通将推两款 3G 四核智能手机处理器

高通将在明年为主流智能手机市场推出两款新的为 3G 网络设计的四核处理器,处理器样品将在明年 6 月前提供给手机厂商。

高通新的 MSM8226 和 MSM8626 处理器将指出目前高端智能手机的标准配置,如 1080p 高清视频捕捉和重放功能以及支持 1300 万像素分辨率的摄像头。

四核处理器目前主要用于高端智能手机,如三星的 GalaxyS3。但是,随着生产成本的下降,高通新的处理器还将为低端手机带来更快的速度。

高通表示,这些芯片将采用 28 纳米生产工艺制造并且支持在中国使用的 CDMA 和 HSPA 标准。中国市场的手机价格一般低于美国和欧洲的价格。高通称,这些芯片是为更长的电池使用寿命优化的,但是,仍然能够提供更高级的图形功能。

联发科今天正式发布 MTK6589 四核处理器

12 月 11 日,联发科就智能手机领域的战略布局及发展规划在深圳福田香格里拉举行客户发布会。

MTK6589 是联发科首个 28nm 制程的四核芯处理器,基于 ARMv7-A 架构,A7 向上兼容 A15,兼顾高性能和低功耗,也被认为是 ARM 历史上能效最高的架构。MT6589 还内建 PowerVRSGX544 图形处理器,三角形输出率为 55M/S,像素填充率为 1600M/S。支持 720P 级别显示分辨率/1080P 级别视频播放,并支持 1300 万像素级别的相机等。联发科 3G 智能手机芯片一向以高性价比见长,此次发布的 MTK6589 四核芯片同样面向千元级别的四核终端,虽然目前都在提倡不要核战要体验,但是智能手机四核、八核的发展趋式已成定局。

士兰微电子推出内置高压 MOSFET 电流模式控制器

士兰微电子的 AC-DC 产品线又推新品-----应用于开关电源的内置高压 MOSFET 电流模式 PWM+PFM 的 AC/DC 控制器 SD6835。该芯片符合能源之星 2.0 标准, 具有低功耗、低启动电流和较低的 EMI, 输出电压和极限输出功率均可调节等特点。目前该新品可以提供的功率范围为: 宽电压范围情况下封闭式适配器 20W, 开放式电源 24W, 窄电压范围情况下封闭式适配器 22W, 开放式电源 26W。

同时, 该新品具有较好的性能特性, 可以根据输出的负荷情况调节开关频率 (25~67KHz) 和峰值电流, 可以通过轻负载的降频模式和峰值电流控制功能提供更高的效率, 也可以通过让芯片在待机模式下进入打嗝模式降低芯片的待机功耗。

Spansion 宣布推出业界首款 45nm 8Gb NOR 闪存

Spansion 公司日前宣布推出业界首款 45 纳米 (nm) 单芯片 8Gb (千兆) NOR 闪存产品。8Gb Spansion® GL-T 可提供高品质的快速随机访问读取性能, 助力游戏和工业应用中的互动图形、动画和视频实现更好的用户体验。

8Gb Spansion GL-T 采用 Spansion 高度可靠的 MirrorBit® 专有技术, 将于下月开始提供样片。45nm Spansion GL-T 系列是 Spansion GL 并行 NOR 产品线的最新成员, 也是 65nm Spansion GL-S 产品系列的补充 (GL-S 容量范围包括 128Mb 至 4Gb)。凭借业界最快的 NOR 闪存读取和编程速度, Spansion 不断拓展与合作, 并成功在诸多应用设计入 GL 产品。该产品系列旨在丰富诸如消费、汽车、游戏、电信和工业应用的用户体验。

首款电容式触摸屏新型示波器面世

日前, 安捷伦科技公司宣布推出 InfiniiVision 4000X 系列多功能示波器, 比采用嵌入式操作系统的同类产品更具灵活性和易用性。4000X 系列共 16 个型号, 带宽涵盖 200MHz—1.5GHz, 高达 100 万次波形/秒的波形捕获率不仅可以连续捕获, 还可连续存储。其次是 12 英寸电容式触摸屏, 是业界同类产品最大尺寸的显示屏, 手指一滑即可完成触发。4000X 系列的主要特点是速度快、易用性和高集成度。其凭借业界最快的波形捕获率始终保持高速运行, 尤其是同时打开逻辑通道、协议解码、数学函数或激活测量时。该系列专为触屏操作而设计, 可使用户轻松、快速地选择测试项目, 并集 5 种仪器功能于一身, 包括示波器、数字通道、协议分析、数字电压表和双通道 WaveGen 函数/任意波形发生器。(来源: 科技日报)

矽映推出首款单芯片、超低功耗、60GHz 智能手机

矽映公司日前宣布推出针对移动设备的全方位无线高清传输器 UltraGig(TM) 6400, 该传输器将 60GHz 射频收发器、基带处理器以及嵌入式天线阵列集成到单一 IC 封装中。这款超低功耗传输器专为智能手机和平板电脑设计, 能够在便携式设备和大型显示器之间建立强大的高清无线视频连接, 提供可与有线连接相媲美的高质量视频。目前, UltraGig 6400 移动 60GHz 无线高清传输器样片开始提供给移动设备制造商使用。

UltraGig 6400 结合了 60GHz 射频收发器的智能波束形成技术以及嵌入式天线阵列, 可提供安全且高带宽的视频连接技术, 和 WirelessHD 兼容的接收器和显示器相连, 从而消除了基于 Wi-Fi 无线方案所有的干扰问题。

美用纳米晶体制成低压柔韧电路

最近, 美国宾夕法尼亚大学研究人员展示了一种硒化镉纳米晶体, 能被“印”或“涂”在柔软塑料上, 制成多种性能优良的电子设备。

论文指导教授谢理·卡甘介绍, 目前便携电脑及其他设备的显示器上用的是非晶硅, 根据硒化镉纳米晶体的性能标准, 其运载电子的速度比非晶体硅要快 22 倍。除了速度快, 硒化镉还有沉积温度上的优势。此外, 研究人员还选用了特殊的配合基, 也就是从纳米晶体表面伸出来的化学链, 能使电路被压入胶片时, 提高其电导率。

纳米晶体可分散在墨水状的液体中, 因此可用多种沉积技术来制作电路, 研究人员所用的是一种旋转喷涂法, 通过离心力拉起表面的一层薄薄溶液。除此之外, 通过浸渍、喷雾或喷墨打印的方式都可以。

这些镉硒化纳米晶体电路为生物医学和安全应用领域的新型设备、各种传感器及其他方面的应用铺平了道路。(来源: 中国集成电路)

西安市科学技术局关于申报 2013 年西安市科技计划项目的通知

各有关单位：

2013 年西安市科技计划围绕落实深化统筹科技资源改革、加快创新驱动发展的目标任务，实施 5 个创新工程、1 个专项和 3 类计划，分别为：企业技术创新工程、技术转移促进工程、科技人才创业工程、科技服务业发展工程、科技金融结合工程，高新技术产业发展专项，现代农业创新计划、社会发展引导计划、创新环境建设计划。

为做好项目申报工作，现将有关事宜通知如下：

一、申报时间和地点

1. 申报时间

2012 年 12 月 15 日-2013 年 1 月 11 日（指南明确另行通知的除外），其中 2012 年 12 月 15 日-29 日受理全部类别项目，2013 年 1 月 2 日-11 日仅受理指定类别项目。

2013 年 1 月 2 日-4 日受理企业技术创新工程、科技人才创业工程项目；

2013 年 1 月 7 日-8 日受理技术转移促进工程、科技服务业发展工程项目；

2013 年 1 月 9 日-11 日受理现代农业创新计划、社会发展引导计划、创新环境建设计划项目。

二、申报程序

1. 登录西安科技网（<http://www.xainfo.gov.cn>）或“西安市科技计划管理信息服务平台”（<http://kjjh.xainfo.gov.cn>），进入西安市科技计划管理信息系统，按要求逐项输入申报内容（含附件），在线提交电子文件；（请于 12 月 4 日以后登录网站）。

2. 提交《西安市科技计划项目申报书》以及指南要求的其他材料，简装成册（一式五份，勿另行加装其他材质封面）。可行性报告、商业计划书、项目实施方案按提供的规范格式编写。

3. 按照隶属关系或所属区域，经主管部门审查盖章后报市科技局。

市属部门及其下属企事业单位，由市属部门负责审查并签章；注册地在“四区一港两基地”和沣东新城的单位，由管委会经贸局审查签章；注册地在区县的单位，由区县科技局会同财政局审查签章；驻市高校、院所和医疗单位，由本单位科研管理部门组织审查后统一申报。

三、申报条件

1. 基本条件

（1）申报单位为西安地区具有独立法人资格的企业、高校、科研院所等各类单位（科技人才创业工程可以拟注册企业为申报主体），具有健全的科研与财务管理制度；

（2）以企业为实施主体的项目，要求企业注册地、纳税地在西安市辖区范围内；

（3）申报 5 个创新工程、高新技术产业发展专项和现代农业创新计划，项目技术领域需符合《西安市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》和市委、市政府《关于加快构建现代产业体系的意见》确定的相关科技产业领域；

（4）项目知识产权明晰。

2. 优先支持

(1) 集成电路设计与制造、云计算应用平台、新一代移动通信、特种金属与复合材料、卫星应用及数据服务、文化创意与数字内容、高端软件和新兴信息服务、创新药物、新能源汽车、先进制造服务等新兴产业技术领域的项目；

(2) 围绕渭北工业区建设、汉长安城遗址保护、秦岭北麓生态环境保护、八水润西安工程、绕城国道连接工程等重大技术需求开展的研发与示范项目；

(3) 产学研协同创新项目；

(4) 通过研究开发预期能取得国际、国家或行业技术标准以及自主知识产权的项目；

(5) 在科技大市场完成技术交易、难题招标，并在本地实施转化的项目；

(6) 国家“千人计划”、省“三秦人才”和“百人计划”、海内外高层次人才及创新团队来我市创新创业项目；

(7) 年销售收入首次达到1亿元、且研发投入占比达到4%以上的民营科技企业的产品与技术开发项目；

(8) 科技企业吸引社会资金投资或获得贷款的项目。

四、项目实施期限

项目实施期限一般为两年（2013.01-2014.12），高新技术产业发展专项为三年（2013.01-2015.12），软科学研究项目为一年。

申报咨询：

西安市科技局计划财务处 西安市科技项目信息管理中心

联系人： 方芳 赵小尊

联系电话：86786643 88405549 88412996

关于申报 2013 年西安市高新技术产业发展专项 计划项目的通知

各有关单位：

为贯彻落实《关于深化统筹科技资源改革加快创新驱动发展的实施意见》，2013年西安市高新技术产业发展专项继续围绕推动高新技术产业规模化发展，以“五区一港两基地”科技企业为主体，支持一批具有引领示范作用的创新集群建设，培育一批重大高新技术产业产业化项目，扶持一批高水平的公共技术平台，支持新兴产业创新基地建设，提升高新技术产业自主创新能力和产业竞争力。

为做好2013年西安市高新技术产业发展专项计划项目申报工作，现将有关事项通知如下：

一、项目申报单位按《指南》要求填写申报材料，送所在园区管委会或区县政府相关部门并备案，由所在园区管委会或区县政府相关部门统一报送；

二、各园区管委会或区县相关部门做好项目征集及初步审查，并出具资金配套承诺函；

三、提交申报材料时间：2012 年 12 月 8 日-2013 年 1 月 8 日；

四、专项指南和申报材料下载网址：

<http://www.xainfo.gov.cn>

<http://www.xadrc.gov.cn>

<http://www.xaczj.gov.cn>

五、材料报送部门及联系人

（一）科技企业发展类

市科技局科技产业处（凤城八路市政府 2 号楼 721 室）

联系人：刘凡军 赵巧云 86786644

（二）高技术产业化示范类

市发改委高技术产业处（凤城八路市政府 7 号楼 333 室）

联系人：刘骥 86786315

（三）市财政局企业处

联系人：宋高阳 87279709

西安 ICC 办公地址搬迁通知

首先，感谢各位长期以来对我们工作的大力支持与配合！因业务发展需要，西安市集成电路产业发展中心、西安集成电路设计专业孵化器有限公司及陕西省半导体行业协会秘书处，自 2011 年 11 月 8 日起搬迁至新地址办公，给您带来的不便，我们深表歉意！

我们将以此次搬迁为一个新的起点，竭诚为各位提供更加满意的服务与合作，再次感谢您长期以来给与的支持与关注！

办公地址：西安市科技二路 77 号光电园 2 号楼 2 层西

电话：029-88328230

传真：029-88316024

固定电话原号码不变，在移机过程中暂停使用，望谅解。